Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Наименование образовательной программы: Промышленная электроника

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ

Блок:	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Часть образовательной программы:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
№ дисциплины по учебному плану:	Б1.Ч.01.06
Трудоемкость в зачетных единицах:	5 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	180 часов
Лекции	5 семестр - 32 часа;
Практические занятия	5 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	5 семестр - 16 часов;
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
Самостоятельная работа	5 семестр - 115,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	проводится в рамках часов аудиторных занятий
включая: Лабораторная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	5 семестр - 0,3 часа;

Москва 2023

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

(должность)



(подпись)

П.А. Рашитов

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель образовательной программы

(должность, ученая степень, ученое звание)

NOSO NOSO	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»									
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ									
NCM	Владелец	Рашитов П.А.								
	Идентификатор	R66e8dfb1-RashitovPA-1953162c								
(полпись)										

a recusionary	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»								
SEE INTERVISION FIRST	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ								
	Владелец	Асташев М.Г.							
<u>Мэи</u> ₹	Идентификатор	R7a29e524-AstashevMG-0583186							

(подпись)

М.Г. Асташев

П.А. Рашитов (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

2

Заведующий выпускающей кафедры

(должность, ученая степень, ученое звание)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: Изучение математических основ анализа, расчета и моделирования электронных аналоговых схем. Приобретение навыков схемотехнического проектирования аналоговых и импульсных схем

Задачи дисциплины

- Знакомство с видами аппроксимации характеристик силовых компонентов схем, а также определению параметров моделей компонентов;
- Знакомство с математическими методами анализа статических режимов работы элементов схем;
- Освоение принципов математического моделирования малосигнальных схем замещения и анализа переходных процессов;
- Приобретение навыков технологии разработки имитационных моделей компонентов и определения их анализа.

Формируемые у обучающегося компетенции и запланированные результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ПК-1 Способен строить физические и математические модели принципиальных схем, блоков, устройств и установок электроники и наноэлектроники, осуществлять моделирование и анализ с использованием стандартных программных средств компьютерного моделирования	ИД-3 _{ПК-1} Умеет строить и верифицировать физические и математические модели модулей, узлов, блоков электронных устройств	знать: - методы определения и проверки параметров моделей полупроводниковых компонентов; - аналитические модели основных полупроводниковых компонентов. уметь: - проводить расчеты усредненных моделей компонентов; - проводить численный расчет режимов работы полупроводниковых компонентов в различных схемных решениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Промышленная электроника (далее — ОПОП), направления подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Базируется на уровне среднего общего образования.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

	D/	В		Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										
No	Разделы/темы дисциплины/формы	сего часо	Семестр				Контан	ктная раб	ота				CP	Содержание самостоятельной работы/
п/п	промежуточной	то ч разд	эме				Консу	льтация	ИК	P		Работа в Подготовка к		методические указания
	аттестации	Всего часов на раздел	ŭ	Лек	Лаб	Пр	КПР	ГК	иккп	ТК	ПА	семестре	аттестации /контроль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аппроксимация характеристик и определение параметров моделей электронных компонентов	50	5	16	4	4	-	-	-	-	-	26	-	Самостоятельное изучение теоретического материала: Изучение дополнительного материала по разделу "Аппроксимация характеристик и определение параметров моделей электронных компонентов"
1.1	Аппроксимация характеристик и определение параметров моделей электронных компонентов	50		16	4	4	-	-	-	1	-	26	-	<u>Изучение материалов литературных</u> <u>источников:</u> [1], стр. 73-115 [2], стр. 15-39
2	Анализ статического режима и малосигнальный анализ электронных схем	40		8	4	4	-	-	-	-	-	24	-	Самостоятельное изучение теоретического материала: Изучение дополнительного материала по разделу "Анализ статического режима и малосигнальный анализ электронных схем"
2.1	Анализ статического режима и малосигнальный анализ электронных схем	40		8	4	4	-	-	-	-	-	24	-	<u>Изучение материалов литературных</u> <u>источников:</u> [1], стр. 1-73 [3], стр. 263-328 [4], стр. 75-80
3	Анализ переходных процессов в нелинейных схемах	36		4	4	4	-	-	-	-	-	24	-	<u>Самостоятельное изучение</u> <u>теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу
3.1	Анализ переходных процессов в нелинейных схемах	36		4	4	4	-	-	-	-	-	24	-	"Анализ переходных процессов в нелинейных схемах" <u>Изучение материалов литературных</u>

													<u>источников:</u> [1], стр. 73-115 [3], стр. 329-338
4	Основы анализа дискретных схем	36	4	4	4	-	-	ı	-	1	24	-	<u>Самостоятельное изучение</u> <u>теоретического материала:</u> Изучение
4.1	Основы анализа дискретных схем	36	4	4	4	-	-	-	-	1	24	-	дополнительного материала по разделу "Основы анализа дискретных схем"
	Зачет с оценкой	18.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	17.7	
	Всего за семестр	180.0	32	16	16	-	-	-	-	0.3	98	17.7	
	Итого за семестр	180.0	32	16	16		-	•		0.3	115.7		

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПР – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

3.2 Краткое содержание разделов

1. Аппроксимация характеристик и определение параметров моделей электронных компонентов

1.1. Аппроксимация характеристик и определение параметров моделей электронных компонентов

Виды аппроксимации, модели диода и стабилитрона, модели биполярных транзисторов, модели полевых транзисторов, модели операционных усилителей и компараторов.

2. Анализ статического режима и малосигнальный анализ электронных схем

2.1. Анализ статического режима и малосигнальный анализ электронных схем

Графические методы анализа статических режимов, аналитический кусочно-линейный анализ. Численные методы. Метод эквивалентных схем, обобщенный матричный метод узловых потенциалов.

3. Анализ переходных процессов в нелинейных схемах

3.1. Анализ переходных процессов в нелинейных схемах

Приближенный анализ в области малых времен, больших времен. Составление дифференциальных уравнений сложных схем по законам Кирхгофа, с помощью М-матрицы. Аналитический и численно-аналитический кусочно-линейных анализ.

4. Основы анализа дискретных схем

4.1. Основы анализа дискретных схем

Выбор структуры, составление математической модели и ее проверка, параметрический синтез, проверочный анализ. Скалярная оптимизация аналитического решения, решение в математической системе.

3.3. Темы практических занятий

- 1. Анализ дискретных схем;
- 2. Применение численных методов решения схемы в переходных процессах;
- 3. Применение численных методов решения статического режима работы компонентов;
- 4. Модели полупроводниковых компонентов. Определение параметров моделей.

3.4. Темы лабораторных работ

- 1. Определение параметров моделей полупроводниковых компонентов;
- 2. Имитационное моделирование работы схемы в статических режимах работы;
- 3. Имитационное моделирование работы схемы в динамических режимах работы;
- 4. Анализ сложной дискретной схемы.

3.5 Консультации

Текущий контроль (ТК)

1. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Аппроксимация характеристик и определение параметров моделей электронных компонентов"

- 2. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Анализ статического режима и малосигнальный анализ электронных схем"
- 3. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Анализ переходных процессов в нелинейных схемах"
- 4. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Основы анализа дискретных схем"

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ

Курсовой проект/ работа не предусмотрены

3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

		Н	омер	разде	ла	Оценочное средство			
Запланированные результаты обучения по	Коды	ДИ	сцип.	лины	(B	(тип и наименование)			
дисциплине	индикаторов	co	ответ		ис				
(в соответствии с разделом 1)	индикаторов		п.3	.1)					
		1	1 2 3		4				
Знать:									
аналитические модели основных	ИД-3пк-1	+				Лабораторная работа/Определение параметров			
полупроводниковых компонентов	ИД- ЗПК-1	Т				моделей полупроводниковых компонентов			
методы определения и проверки параметров моделей						Лабораторная работа/Имитационное			
полупроводниковых компонентов	ИД-3 _{ПК-1}		+			моделирование работы схемы в статических			
						режимах работы			
Уметь:									
проводить численный расчет режимов работы						Лабораторная работа/Анализ сложной			
полупроводниковых компонентов в различных	ИД-3 _{ПК-1}				+	дискретной схемы			
схемных решениях									
проводить расчеты усредненных моделей						Лабораторная работа/Имитационное			
компонентов	ИД-3 _{ПК-1}			+		моделирование работы схемы в динамических			
						режимах работы			

4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

4.1. Текущий контроль успеваемости

5 семестр

Форма реализации: Защита задания

- 1. Анализ сложной дискретной схемы (Лабораторная работа)
- 2. Имитационное моделирование работы схемы в динамических режимах работы (Лабораторная работа)
- 3. Имитационное моделирование работы схемы в статических режимах работы (Лабораторная работа)
- 4. Определение параметров моделей полупроводниковых компонентов (Лабораторная работа)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Зачет с оценкой (Семестр №5)

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих.

В диплом выставляется оценка за 5 семестр.

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Печатные и электронные издания:

- 1. Недолужко, И. Г. Учебное пособие по курсу "Методы анализа и расчета электронных схем": Методы анализа и расчеты электронных схем в примерах и задачах / И. Г. Недолужко; Ред. П. А. Воронин; Моск. энерг. ин-т (МЭИ). М.: Изд-во МЭИ, 1991. 72 с.;
- 2. Филиппов, Е. Нелинейная электротехника : пер. с нем. / Е. Филиппов . 2-е изд., перераб. и доп . М. : Энергия, 1976 . 496 с.;
- 3. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс) : Учебник для вузов по специальности "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров . М. : Горячая Линия-Телеком, 1999 . 768 с. ISBN 5-935170-02-7 : 115.00 .;
- 4. Н. С. Легостаев, К. В. Четвергов- "Методы анализа и расчета электронных схем", Издательство: "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники", Томск, 2014 (230 с.) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480509.

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- 1. СДО "Прометей";
- 2. Office / Российский пакет офисных программ;
- 3. Windows / Операционная система семейства Linux;
- 4. Майнд Видеоконференции;
- 5. SimInTech;

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационносправочные системы:

- 1. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/
- 2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" -

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red

- 3. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/
- 4. База данных ВИНИТИ online http://www.viniti.ru/
- 5. База данных журналов издательства Elsevier https://www.sciencedirect.com/
- 6. Электронные ресурсы издательства Springer https://link.springer.com/
- 7. База данных Web of Science http://webofscience.com/
- 8. База данных Scopus http://www.scopus.com
- 9. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/
- 10. ЭБС "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/
- 11. Электронная библиотека МЭИ (ЭБ МЭИ) http://elib.mpei.ru/login.php

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории,	Оснащение
	наименование	
Учебные аудитории для	Ж-120, Машинный зал	сервер, кондиционер
проведения лекционных	ИВЦ	
занятий и текущего	Б-305, Учебная	парта со скамьей, стул, доска меловая,
контроля	аудитория	мультимедийный проектор, кондиционер
Учебные аудитории для	Ж-120, Машинный зал	сервер, кондиционер
проведения	ИВЦ	
практических занятий,	Б-305, Учебная	парта со скамьей, стул, доска меловая,
КР и КП	аудитория	мультимедийный проектор, кондиционер
Учебные аудитории для	E-1016,	стол, стул, шкаф, тумба, компьютерная
проведения	Компьютерный класс	сеть с выходом в Интернет,
лабораторных занятий		мультимедийный проектор, доска
		маркерная, компьютер персональный
Учебные аудитории для	Е-101б,	стол, стул, шкаф, тумба, компьютерная
проведения	Компьютерный класс	сеть с выходом в Интернет,
промежуточной		мультимедийный проектор, доска
аттестации		маркерная, компьютер персональный
	Ж-120, Машинный зал	сервер, кондиционер
	ИВЦ	
	Б-305, Учебная	парта со скамьей, стул, доска меловая,
	аудитория	мультимедийный проектор, кондиционер
Помещения для	НТБ-303,	стол компьютерный, стул, стол
самостоятельной	Компьютерный	письменный, вешалка для одежды,
работы	читальный зал	компьютерная сеть с выходом в
		Интернет, компьютер персональный,
		принтер, кондиционер
Помещения для	E-324/6,	кресло рабочее, стул, шкаф для
консультирования	Преподавательская	документов, стол письменный, тумба,
	каф. "Пром.эл."	компьютерная сеть с выходом в
		Интернет, многофункциональный центр,
		компьютер персональный
Помещения для	E-324/5,	парта, стул, вешалка для одежды,

хранения оборудования	Методический	компьютерная сеть с выходом в
и учебного инвентаря	кабинет каф.	Интернет, мультимедийный проектор,
	"Пром.эл."	доска маркерная передвижная, ноутбук

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Методы расчета электронных схем

(название дисциплины)

5 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Определение параметров моделей полупроводниковых компонентов (Лабораторная работа)
- КМ-2 Имитационное моделирование работы схемы в статических режимах работы (Лабораторная работа)
- КМ-3 Имитационное моделирование работы схемы в динамических режимах работы (Лабораторная работа)
- КМ-4 Анализ сложной дискретной схемы (Лабораторная работа)

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ: Неделя КМ:	KM- 1 4	KM- 2 8	KM- 3 12	KM- 4 14
1	Аппроксимация характеристик и определение параметров моделей электронных компоненто					
1.1	Аппроксимация характеристик и определение параметров моделей электронных компоненто		+			
2	Анализ статического режима и малосигнальны электронных схем	ий анализ				
2.1	Анализ статического режима и малосигнальны электронных схем	ый анализ		+		
3	Анализ переходных процессов в нелинейных с	схемах				
3.1	Анализ переходных процессов в нелинейных с	схемах			+	
4	Основы анализа дискретных схем					
4.1	Основы анализа дискретных схем					+
	I	Bec KM, %:	30	30	25	15